

2項 第2回ECS SiGe & Ge : 材料・プロセス・デバイス国際会議(2節 国際会議等の開催状況, 第5章 国際会議・シンポジウム等)

雑誌名	東北大学電気通信研究所研究活動報告
号	13
ページ	276
発行年	2006
URL	http://hdl.handle.net/10097/40693

第2回 ECS SiGe & Ge : 材料・プロセス・デバイス国際会議

2nd ECS SiGe & Ge: Materials, Processing, and Devices Symp.

開催日：平成 18 年 10 月 29 日～11 月 3 日（6 日間）

開催場所：カンクン（メキシコ）

本国際会議は、近年、関心が高まっている SiGe と Ge に関連する材料・プロセス・デバイスに関して包括的に議論することを目的として 2004 年に第 1 回目が開催され、今回は第 2 回目の開催である。本研究所附属ナノ・スピン実験施設からは、組織委員として室田淳一教授（General Committee）と櫻庭助教授（Epitaxy Committee）が参加し、全参加者は 180 名に達した。基調講演 2 件及び招待講演 33 件の他、一般口頭発表 59 件とショート口頭講演 32 件が行われるとともに、“Germanium for CMOS” ワークショップ（発表 5 件）も開催され、最新の SiGe と Ge に関する研究動向の報告とともに活発で有意義な討論が交わされた。また、上記の全発表（131 件）が学術論文としてまとめられ、その論文集は 2006 年 10 月に学術論文誌 ECS Transaction (Vol.3, Issue 7, 2006) の特集号として出版されている。すでに次回の継続開催（2008 年秋、ハワイ）も決定され、世界の英知を結集した討論の場が準備されている。今後、この分野の研究が推進されることにより、IV 族半導体極限ヘテロ構造の学問分野が大きく展開するであろう。